

850nm 2.5Gbps GaAs PIN PD Chip $\phi 75\mu\text{m}$



产品描述

850nm GaAs PIN 高速光探测器芯片

产品特点

数据速率高达 2.5Gbps; $\phi 75\mu\text{m}$ 有效面积; 850nm 高响应度; 顶照式平面结构

应用领域

850nm AOC 接收器 | 1-5Gbps 光纤通道 | 多模光纤数据通信 | 短距离光纤网络

核心参数

无
无

详细参数

规格 (Tc=25°C, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ		850	860	nm	
响应度	R	0.55	0.6		A/W	$\lambda=850\text{nm}$
暗电流	I_D		0.05	0.3	nA	$V_R=-5V$
电容	C		0.3	0.4	pF	$V_R=-2V, f=1\text{MHz}$
带宽	Bw		6.0		GHz	$V_R=-2V$ 3dB down, $R_L=50\Omega$
有效区直径	D		75		μm	
通道之间的中心 间距(pitch)			250*250*150		μm	L*W*H